

★電子デバイス研究会 (ED)

専門委員長 須原理彦 副委員長 藤代博記
幹事 岩田達哉・小谷淳二 幹事補佐 堤 卓也

★マイクロ波研究会 (MW)

専門委員長 古神義則 副委員長 河合 正・大久保賢祐・新庄真太郎
幹事 佐藤 優・大平昌敬 幹事補佐 高野恭弥・長谷川直輝

日時 1月29日(金) 10:30~16:40

会場 オンライン開催

議題 化合物半導体 IC 及び超高速・超高周波デバイス/マイクロ波一般

MW 研 一般講演 (10:25~12:10)

1. 電磁界結合型 2 分の 1 波長共振器フィルタの設計理論に関する研究 ○二ツ矢幹基・石崎俊雄 (龍谷大)
2. 複数放射素子・複数共振器で構成される 3 直交軸成分放射 60 GHz 帯平面アンテナの測定評価
○大平昌敬・馬 哲旺 (埼玉大)
3. 異なるタイミングの位相情報を用いた Time to Digital Converter の試作結果 ○森野芳昭・津留正臣 (三菱電機)
4. 2 周波混合ベクトル合成型移相器を用いた V 帯受信 RFIC の試作結果
○横溝真也・森野芳昭・津留正臣 (三菱電機)

午後 ED 研 一般講演 (13:00~14:15)

5. HfSiO_x/AlGa_N/Ga_N MOS-HEMT のゲート制御性 ○越智亮太 (北大)・前田瑛里香 (芝浦工大/物材機構)・生田目俊秀 (物材機構)・塩崎宏司 (名大)・橋詰 保 (北大/名大)
6. 異なるトラップを持つ AlGa_N/Ga_N HEMT における 2 次元デバイスシミュレーションによるサイドゲート効果の解析
○伊藤海到・大石敏之 (佐賀大)
7. β -Ga₂O₃ MOSFET の高周波特性評価と遅延時間解析 ○上村崇史・中田義昭・東脇正高 (NICT)

MW 研 一般講演 (14:25~15:40)

8. 界面不純物低減による Ga_N 基板上 Ga_N-HEMT の高効率化 ○熊崎祐介・多木俊裕・小谷淳二・尾崎史朗 (富士通/富士通研)・新井田佳孝 (富士通研)・美濃浦優一 (富士通/富士通研)・西森理人 (富士通)・岡本直哉 (富士通/富士通研)・佐藤 優・中村哲一 (富士通研)・渡部慶二 (富士通/富士通研)
9. ミリ波帯用 InGaAs HEMT 寄生抵抗抽出高精度化の検討 ○谷口慶伍 (東京理科大)・細谷友崇 (東北大)・株田洋太郎・高野恭弥 (東京理科大)・末光哲也・佐藤 昭 (東北大)
10. ゲート容量負荷部の高調波処理による CMOS スタック増幅器の高効率化検討
○竹添慎司・森野芳昭・津留正臣 (三菱電機)

MW 研 招待講演 (15:50~16:40)

11. [招待講演] 次世代電力増幅器の高効率化技術と歪み補償技術
○山岡敦志・ホーン トーマス・江頭慶真・山口恵一 (東芝)

◆IEEE MTT-S Japan Chapter/IEEE MTT-S Kansai Chapter/IEEE MTT-S Nagoya Chapter 協賛

☆ED 研究会

【問合先】

岩田達哉 (富山県立大)

TEL [0766] 56-7500

E-mail: t_iwata@pu-toyama.ac.jp

小谷淳二 (富士通研)

E-mail: kotani.junji-01@fujitsu.com

☆MW 研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

3月4日(木), 5日(金) 広島大東広島キャンパス [未定] テーマ:マイクロ波一般

【発表申込先】 研究会発表申込システムからお申込み下さい。 <https://www.ieice.org/ken/program/index.php>

【問合先】

佐藤 優 (富士通研)

E-mail: sato.masaru@fujitsu.com

大平昌敬 (埼玉大)

E-mail: mohira@mail.saitama-u.ac.jp

◎MW 研からのお知らせ

2020年度より, 各年度の MW 研の全発表の中から, 優秀な研究発表を行った学生講演者を対象として「学生研究優秀発表賞」と「学生研究発表奨励賞」を選定します。